

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Том: 56 Номер: 9 Год: 2022

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ "НАНОФИЗИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА", НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14- 17 МАРТА 2022 Г. @X

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА ТУННЕЛЬНО-СВЯЗАННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДУЛЯТОРА ПО СХЕМЕ МАХА--ЦЕНДЕРА

Бобров А.И., Байдусь Н.В., Хазанова С.В., Горшков А.П., Сидоренко К.В., Шушунов А.Н., Малехонова Н.В., Нежданов А.В., Здоровейщев А.В., Трушин В.Н., Убийвовк Е.В., Охапкин А.И., Клементьев Д.С., Гасайниев З.Ш., Харламов А.В. 833-838

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ GE И GESN, ВЫРАЩЕННЫХ НА N⁺-SI(001)-ПОДЛОЖКАХ

Титова А.М., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Алябина Н.А., Здоровейщев А.В., Шенгуров В.Г. 839-843

АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ДРНЕМТ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ GAAS/INGAAS С ДВУСТОРОННИМ ДЕЛЬТА-ЛЕГИРОВАНИЕМ

Тарасова Е.А., Хазанова С.В., Голиков О.Л., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Земляков В.Е. 844-847

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ С ПЛАЗМЕННОЙ АКТИВАЦИЕЙ АЗОТА ГЕТЕРОСТРУКТУР С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ INN/INGAN НА САПФИРЕ

Калинников М.А., Лобанов Д.Н., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А., Юнин П.А., Красильникова Л.В., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Красильник З.Ф. 848-854

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРЕБЕНЧАТОГО ВОЛНОВОДА ЛАЗЕРА НА ОСНОВЕ HGCSDTE ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОДНОМОДОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ИК ДИАПАЗОНА

Дубинов А.А., Морозов С.В. 855-857

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СИМПОЗИУМА ЗАВЕРШЕНА. @X О НЕЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ (АТОМНАЯ СТРУКТУРА, ДИФФУЗИЯ)

РАСТВОРИМОСТЬ МАГНИЯ В КРЕМНИИ

Шуман В.Б., Лаврентьев А.А., Яковлева А.А., Abrosimov N.V., Лодыгин А.Н., Порцель Л.М., Астров Ю.А. 858-861

ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ AG₈GE_{1-x}MN_xTE₆

Рагимов Р.Н., Кахраманова А.С., Араслы Д.Г., Халилова А.А., Мамедов И.Х., Халилзаде А.Р. 862-865

ВЯЗКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Алексеев П.С. 866-875

СПЕКТРОСКОПИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗЛУЧЕНИЯМИ

СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ INAS/INASSB/INASSBP С АСИММЕТРИЧНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ

Семакова А.А., Ружевиц М.С., Романов В.В., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Моисеев К.Д. 876-881

НАКОПЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ α-GA₂O₃ ИОНАМИ R И PF₄

Карасев П.А., Карабешкин К.В., Стручков А.И., Печников А.И., Николаев В.И., Андреева В.Д., Титов А.И. 882-887

ПОВЕРХНОСТЬ, ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ

ПЛЕНКИ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ ТОЛЩИНОЙ 2-10 НМ НА КРЕМНИИ-(111): ВЫРАЩИВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ИЗУЧЕНИЕ СКВОЗНОГО ТОКОПЕРЕНОСА

Банщиков А.Г., Векслер М.И., Иванов И.А., Илларионов Ю.Ю., Соколов Н.С., Сутурин С.М. 888-892

ПОЛЯРОННАЯ МАССА НОСИТЕЛЕЙ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ НА ИОННЫХ ПОДЛОЖКАХ

Маслов А.Ю., Прошина О.В. 893-896

МИКРО- И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОРИСТЫЕ, КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (BI_{2-x}SB_x)TE₃ (0<x<2)<span=""></x<2)<>

Степанов Н.П., Иванов М.С., Степанова Л.Э., Виноградова Л.В. 897-903

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

КРЕМНИЕВЫЕ СВЕТОДИОДЫ С ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЕЙ, СФОРМИРОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ КИСЛОРОДНЫХ ПРЕЦИПИТАТОВ

Соболев Н.А., Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Аруев П.Н., Забродский В.В., Шек Е.И. 904-907

ПОВЕРХНОСТНО-ИЗЛУЧАЮЩИЕ КВАНТОВО-КАСКАДНЫЕ ЛАЗЕРЫ С ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ, СФОРМИРОВАННОЙ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ	908-914
<i>Бабичев А.В., Михайлов Д.А., Колодезный Е.С., Гладышев А.Г., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Денисов Д.В., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Дюделев В.В., Евтихий В.П., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Соколовский Г.С., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю.</i>	
АНАЛИЗ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МДП-СТРУКТУР С ALD AL₂O₃ НА N- И P-СДНГТЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОМ СВЕРХТОНКИМ СОБСТВЕННЫМ ОКСИДОМ	915-921
<i>Закиров Е.Р., Кеслер В.Г., Сидоров Г.Ю., Горшков Д.В., Ковчавцев А.П.</i>	
ВНУТРЕННИЕ ПОТЕРИ В ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРАХ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ ЯМА-ТОЧЕК	922-927
<i>Жуков А.Е., Надточий А.М., Крыжановская Н.В., Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Серин А.А., Минтаилов С.А., Калюжный Н.А., Паюсов А.С., Корнышов Г.О., Максимов М.В., Wang Y.</i>	
ФОТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ СТРУКТУР Ga₂O₃/N-GAAS, СПОСОБНЫЕ РАБОТАТЬ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ	928-932
<i>Калыгина В.М., Киселева О.С., Кушнарёв Б.О., Олейник В.Л., Петрова Ю.С., Цымбалов А.В.</i>	
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВОЛНОВОДНОГО СЛОЯ НА ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР INGAALAS/INP СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1550 НМ	933-939
<i>Новиков И.И., Няпшаев И.А., Гладышев А.Г., Андрюшкин В.В., Бабичев А.В., Карачинский Л.Я., Шерняков Ю.М., Денисов Д.В., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е., Егоров А.Ю.</i>	